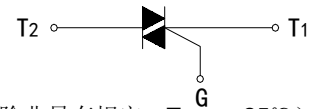


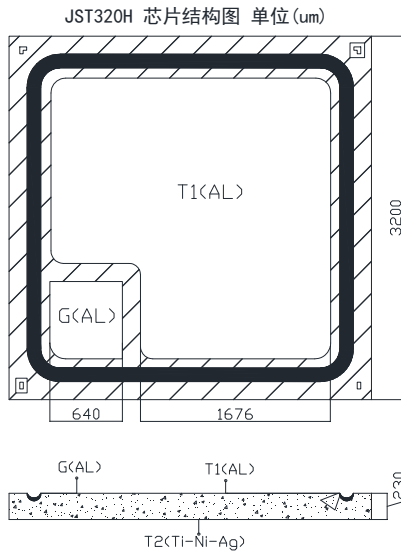
JST320H 高结温型三象限双向晶闸管芯片

(芯片代码: CP307)

- 芯片特征: 单面台面结构, 台面玻璃钝化工艺, 背面三层金属电极。
- 芯片尺寸: 3.2mm×3.2mm
- 可替换型号: BCR8PM、T835H



○ 产品极限参数 (封装成 TO-220F 后, 除非另有规定, $T_{CASE}=25^{\circ}C$)



参数名称	符号	数值	单位	
结温范围	T_j	-40~150	$^{\circ}C$	
正向断态重复峰值电压	V_{DRM}	600/800	V	
反向断态重复峰值电压	V_{RRM}	600/800	V	
通态均方根电流 $T_C=113^{\circ}C$	$I_T(RMS)$	8	A	
通态浪涌电流	I_{TSM}	$tp=20mS$	80	A
		$tp=16.7mS$	84	
i^2t 值 $tp=10mS$	i^2t	32	A^2S	
通态电流临界上升率 $I_G=2 \times I_{GT}, tr \leq 100ns, F=100Hz$	di/dt	50	A/uS	
门极峰值电流 $T_j=150^{\circ}C$	I_{GM}	2	A	
门极平均功率 $T_j=150^{\circ}C$	$P_G(AV)$	1	W	

○ 产品电性能 (封装成 TO-220 后, 除非另有规定, $T_{CASE}=25^{\circ}C$)

特性和测试条件	符号	数值			单位
		20	35	50	
通态峰值电压 $I_{TM}=11A, tp=380uS$	V_{TM}	≤ 1.55			V
正向断态峰值电流 $T_C=25^{\circ}C$	I_{DRM1}	≤ 5			μA
$V_D=V_{DRM}$ $T_C=150^{\circ}C$	I_{DRM2}	≤ 1.5			mA
反向断态峰值电流 $T_C=25^{\circ}C$	I_{RRM1}	≤ 5			μA
$V_R=V_{RRM}$ $T_C=150^{\circ}C$	I_{RRM2}	≤ 1.5			mA
门极触发电压 $V_D=12V, R_L=30\Omega$	V_{GT}	≤ 1.5			V
门极不触发电压 $V_D=V_{DRM}, R_L=3.3K\Omega, T_j=150^{\circ}C$	V_{GD}	≥ 0.2			V
门极触发电流 $V_D=12V, R_L=30\Omega$	$I_{GT}(I-II-III)$	≤ 20	≤ 35	≤ 50	mA
擎住电流 $I_G=1.2I_{GT}$	$I_L(I-III)$	≤ 40	≤ 50	≤ 70	mA
	$I_L(II)$	≤ 55	≤ 70	≤ 100	
维持电流 $I_T=0.2A$	I_H	≤ 30	≤ 45	≤ 60	mA
换向电压临界上升率 $V_D=400V$ $T(vj)=150^{\circ}C$ $(di/dt)_c=-3.5A/ms$	$(dV/dt)_c$	≥ 5	≥ 15	≥ 20	V/uS